**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są rezysty do litografii nanoimprintowej :

1. **Parametry**

**2.1 Szczegółowy zakres przedmiotu**

| Nazwa towaru | Parametr  | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| Rezysty do litografii nanoimprintowe | Rezyst NILgrubość folii - 100 nm | Technologia Imprintu | Foto, UV-NIL (i-line) |
| Temperatura imprintu  | ≈ Tg + 60 K(Tg = temperatura zeszklenia) |
| Zastosowanie | do odciskania małych wzorów w miękkich procesach UV-NIL |
| Intensywność źródła światła | <40 mW cm-2 |
| Stabilność suchego wytrawiania | Podłoża - krzem, kwarc, aluminium |
| Pojemność | 250 ml |
| Rezyst NILgrubość folii- 2 μm | Technologia Imprintu | Foto, UV-NIL (i-line) |
| Temperatura imprintu  | ≈ Tg + 60 K(Tg = temperatura zeszklenia) |
| Zastosowanie | dla gazo-przepuszczalnych materiałów stemplowych w miękkich procesach UV-NIL |
| Intensywność źródła światła | <40 mW cm-2 |
| Stabilność suchego wytrawiania | Podłoża - krzem, kwarc, aluminium |
| Pojemność | 250 ml |
| Rezyst NILgrubość folii - 800 nm | Technologia Imprintu | Foto, UV-NIL (i-line) |
| Temperatura imprintu  | ≈ Tg + 60 K(Tg = temperatura zeszklenia) |
| Zastosowanie | dla gazo-przepuszczalnych materiałów stemplowych w miękkich procesach UV-NIL |
| Intensywność źródła światła | <40 mW cm-2 |
| Stabilność suchego wytrawiania | Podłoża - krzem, kwarc, aluminium |
| Pojemność | 250 ml |
| Rozpuszczalnik do fotorezystów | Technologia | Organic solvent based thinner |
| Zastosowanie | Rozpuszczalnik do folii i polimerów hybrydowych |
| Grubość warstwy polimerów hybrydowych i folii | < 0,5 µm |
| Pojemność | 500 ml |
| Środek zwiększający przyczepność | Technologia nakładania | metoda wirowania |
| Zastosowanie | umożliwia usuwanie trudnych do usunięcia fotorezystówzwiększa adhezję |
| Środek zwiększający przyczepność | do trudnych podłoży, takich jak Au, Cu i kwarc |
| Pojemność | 500 ml |